

# 二极管反向恢复时间测试仪

产品名称	二极管反向恢复时间测试仪
公司名称	西安天光测控技术有限公司
价格	599.00/台
规格参数	品牌:天光测控 型号:ST-DP_X 1200 测试范围:IGBTs,MOSFET
公司地址	陕西省西安市高陵区泾环北路1798号11-303
联系电话	15596668116

## 产品详情

二极管反向恢复时间测试仪用于测试器件级的 Diode,IGBT,MOSFET动态交流参数1200V/100A , 短路电流2500A替代ITC57300 , 多项功能及指标优于ITC57300

### 技术规格

#### 基础能力

\*大输出能力：电压1200V电流200A

\*小时间测量值：0.1ns

Windows系统的控制计算机水印签字\*西安天光测控\*水印签字

LabVIEW软件界面水印签字\*西安天光测控\*水印签字

#### 物理规格

单机尺寸：800 × 800 × 1800mm水印签字\*西安天光测控\*水印签字

质量：165kg水印签字\*西安天光测控\*水印签字

系统功耗：200w

ST-AC1200\_S\_R开关时间（阻性）测试单元 美军标750方法为3472

脉宽：0.1us~100us步进0.1s

栅极电压：0~20V，分辨率0.1V

栅极电流\*大10A水印签字\*西安天光测控\*水印签字

漏极电流\*大75A（支持扩展200A、500A）

占空比小于0.1%水印签字\*西安天光测控\*水印签字

VDD/漏极电压 5V~100 V分辨率0.1V

100 V~1200V分辨率1.0VST-

AC1200\_D反向恢复特性测试单元 美军标750方法3473

IF/正向电流：0.1~50A@0.1A分辨率

50~200A@0.5A分辨率

di/dt/反向电流斜率：25-600A/uS 1.0A/ns Steps

VR/反向电压：20~1200V

IRM/反向电流：总正向和反向\*大电流200A以内。

占空比：< 1.0%水印签字\*西安天光测控\*水印签字

TRR/反向恢复时间范围：1ns~2us

VDD/漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps

100V~1200 V，1.0V Steps

Qrr/反向恢复电荷：0.1nC~100uC

ST-AC1200\_Q栅电荷测试单元 美军标750，方法3471

栅极电流：0~10mA@10uA分辨率

栅级电压：0~20V@0.1V分辨率

漏极电流（固态负载）：1~25A@0.1A分辨率

分辨率水印签字\*西安天光测控\*水印签字

漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps

100V~1200 V，1.0V StepsST-

AC1200\_S\_L开关时间（感性）测试单元美军标750，方法3477

漏极电流：1.0~50A@0.2A分辨率

电感：0.1mH至159.9mH（外挂）

栅极电压：0~20V@0.1V分辨率

漏极电压：5V~100V，0.1V Steps

，1.0V Steps

ST-AC1200\_S短路特性测试单元美军标750，方法3479

\*大电流：标配200A（选配1000A）

脉宽：1us~100us

漏极电压5V~100V，0.1V Steps

100V~1200 V，1.0V Steps ST-AC1200\_RC栅电阻结电容测试单元 JEDEC Std JESD24-11

Rg/栅电阻：0.1~100 水印签字\*西安天光测控\*水印签字

结电容参数：Ciss，Coss，Crss

漏极偏置电压：1200V\*大

栅极偏置电压：0~20V@0.1V分辨率

频率：标配0.1MHZ~1MHZ

电网环境

AC220V ± 10%，50Hz ± 1Hz。水印签字\*西安天光测控\*水印签字

MOSFET动态参数测试仪主要用于测试二极管、IGBT、MOS动态特性参数，产品功能指标对标ITC57300，对标资料如下。

资料说明：

对比内容：半导体分立器件动态参数测试系统

对比厂商：美国ITC公司（下文简称ITC）、西安天光测控技术有限公司（下文简称西安天光）

对比型号：ITC/ITC57300、西安天光/ST-AC1200\_X

MOSFET动态参数测试仪以ITC57300作为参考标准，西安天光的产品资料中“蓝色字体”为西安天光的减分项（指标低于ITC57300），“红色字体”为西安天光的加分项（指标高于ITC57300），“黑色字体”表示双方指标一致。

美国ITC公司ITC57300西安天光测控技术有限公司ST-AC1200\_X基础能力\*大输出能力：电压1200V电流200A\*小时间测量值：1.0ns Windows系统的控制计算机LabVIEW软件界面水印签字\*西安天光测控\*水印签字 物理规格高=76英寸宽=44英寸(包括显示器和键盘)深=50英寸(包括接收器)重=550磅 ITC57210开关时间（阻性）测试单元美军标750方法为3472脉宽：0.1s~10s

步进0.1s栅极电压  $\pm 20V$ 分辨率0.1V栅极电流\*大1.0A漏极电流\*大200A占空比小于0.1%VDD/漏极电压5V~100 V分辨率0.1V 100 V~1200V分辨率1.0V水印签字\*西安天光测控\*水印签字ITC57220反向恢复特性测试单元美军标750方法3473IF/正向电流：ITC5722B：1.0~50A@0.2A分辨率分辨率di/dt/反向电流斜率：25-600A/uS 1.0A/ns StepsVR/反向电压：20~1200VIRM/反向电流：总正向和反向\*大电流200A以内。占空比： $< 1.0\%$ TRR/反向恢复时间范围：10ns~2.0usVDD/漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps 100V~1200 V，1.0V StepsQrr/反向恢复电荷：1nC~100uCW水印签字\*西安天光测控\*水印签字ITC57230栅电荷测试单元美军标750方法3471栅极电流：低0~2.0mA@0.01mA分辨率中2.0~20.0mA@0.1mA分辨率20.0~200.0 mA@1.0mA分辨率栅电压范围： $\pm 20V$ @ $\pm 0.1V$ 分辨率漏极电流（固态负载）：1~25A@0.1A分辨率分辨率漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps100V~1200 V，1.0V Steps水印签字\*西安天光测控\*水印签字ITC57240开关时间（感性）测试单元美军标750方法3477漏极电流：1.0~50A@0.2A分辨率分辨率电感：0.1mH至159.9mH栅极电压： $\pm 20V$ @0.1V分辨率漏极电压：5V~100V，0.1V Steps，1.0V Steps水印签字\*西安天光测控\*水印签字ITC57250短路特性测试单元美军标750方法3479\*大电流：1000A脉宽：1us~100us栅驱电压： $\pm 20V$ @0.1V分辨率漏极电压5V~100V，0.1V Steps100V~1200 V，1.0V Steps水印签字\*西安天光测控\*水印签字ITC57260栅电阻结电容测试单元JEDEC StdJESD24-11Rg/栅电阻：0.1~50m 结电容参数：Ciss，Coss，Crss漏极偏置电压：1200V\*大栅极偏置电压： $\pm 20V$ 频率：0.1MHZ~4 MHZ电网环境220V 50~60 Hz单相 可选择240V220V/12A 20A 30A水印签字\*西安天光测控\*水印签字基础能力\*大输出能力：电压1200V电流200A\*小时间测量值：0.1nsWindows系统的控制计算机LabVIEW软件界面水印签字\*西安天光测控\*水印签字物理规格单机尺寸：800 x 800 x 1800mm质量：165kg系统功耗：200wST-AC1200\_S\_R开关时间（阻性）测试单元 美军标750方法为3472脉宽：0.1us~10 0us步进0.1s栅极电压：0~20V，分辨率0.1V栅极电流\*大10A漏极电流\*大75A（支持扩展200A、500A）占空比小于0.1%VDD/漏极电压 5V~100 V分辨率0.1V 100 V~1200V分辨率1.0V水印签字\*西安天光测控\*水印签字ST-AC1200\_D反向恢复特性测试单元 美军标750方法3473IF/正向电流：0.1~50A@0.1A分辨率50~200A@0.5A分辨率di/dt/反向电流斜率：25-600A/uS 1.0A/ns StepsVR/反向电压：20~1200VIRM/反向电流：总正向和反向\*大电流200A以内。占空比： $< 1.0\%$ TRR/反向恢复时间范围：1ns~2usVDD/漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps 100V~1200 V，1.0V StepsQrr/反向恢复电荷：0.1nC~10 0uCW水印签字\*西安天光测控\*水印签字ST-AC1200\_Q栅电荷测试单元 美军标750，方法3471栅极电流：0~10mA@10uA分辨率栅级电压：0~20V@0.1V分辨率漏极电流（固态负载）：1~25A@0.1A分辨率水印签字\*西安天光测控\*水印签字漏极电压：5V~100 V，0.1V Steps100V~1200 V，1.0V StepsST-AC1200\_S\_L开关时间（感性）测试单元美军标750，方法3477漏极电流：1.0~50A@0.2A分辨率分辨率电感：0.1mH至159.9mH（外挂）栅极电压：0~20V@0.1V分辨率漏极电压：5V~100V，0.1V Steps，1.0V Steps水印签字\*西安天光测控\*水印签字ST-AC1200\_S短路特性测试单元美军标750，方法3479\*大电流：标配200A（选配100 0A）脉宽：1us~100us栅极电压：0~20V@0.1V分辨率漏极电压5V~100V，0.1V Steps100V~1200 V，1.0V Steps水印签字\*西安天光测控\*水印签字ST-AC1200\_RC栅电阻结电容测试单元 JEDEC Std JESD24-11Rg/栅电阻：0.1~100 结电容参数：Ciss，Coss，Crss漏极偏置电压：1200V\*大栅极偏置电压：0~20V@0.1V分辨率频率：标配0.1MHZ~1MHZ（3W）0.1MHZ~4MHZ（15W）水印签字\*西安天光测控\*水印签字电网环境AC220V  $\pm 10\%$ ，50Hz  $\pm 1Hz$ 。其它测试功能（加分项）

## 雪崩特性测试单元

EAS

IAS

PAS

di/dt测试单元

dv/dt测试单元

静态参数测试单元（可测试IGBT、MOSFET、二极管的静态直流参数）

安全工作区/RBSOA

热阻（包括稳态热阻和瞬态热阻）

产品系列晶体管图示仪半导体分立器件测试筛选系统静态参数（包括  $I_{GEs}$  /  $V_{GE(th)}$  /  $V_{CEsat}$  /  $V_F$  /  $I_{CEs}$  /  $V_{CEs}$ 等）动态参数（包括  $Turn\_ON\&OFF\_L$  /  $Q_{rr\_FRD}$  /  $Q_g$  /  $R_g$  /  $UIS$  /  $SC$  /  $RBSOA$ 等）环境老化（包括  $HTRB$  /  $HTGB$  /  $H3TRB$  /  $Surge$ 等）热特性（包括  $PC$  /  $TC$  /  $R_{th}$  /  $Z_{th}$  /  $K_{curve}$ 等）可测试 Si / SiC / GaN 材料的 IGBTs / MOSFETs / DIODEs / BJTs / SCRs等功率器件